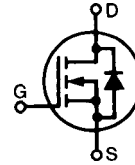


# HiPerFET™ Power MOSFETs

**IXFH/IXFM11N80**  
**IXFH/IXFM13N80**

N-Channel Enhancement Mode  
High dv/dt, Low  $t_{rr}$ , HDMOS™ Family

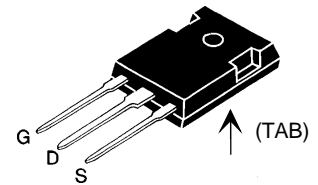


$V_{DSS}$	$I_{D25}$	$R_{DS(on)}$
<b>800 V</b>	<b>11 A</b>	<b>0.95 <math>\Omega</math></b>
<b>800 V</b>	<b>13 A</b>	<b>0.80 <math>\Omega</math></b>

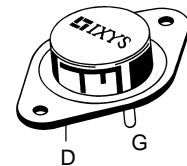
$t_{rr} \leq 250 \text{ ns}$

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
$V_{DSS}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to $150^\circ\text{C}$	800	V
$V_{DGR}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to $150^\circ\text{C}$ ; $R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	800	V
$V_{GS}$	Continuous	$\pm 20$	V
$V_{GSM}$	Transient	$\pm 30$	V
$I_{D25}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	11N80	11 A
		13N80	13 A
$I_{DM}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$ , pulse width limited by $T_{JM}$	11N80	44 A
		13N80	52 A
$I_{AR}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	11N80	11 A
		13N80	13 A
$E_{AR}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	30	mJ
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$ , $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$ , $V_{DD} \leq V_{DSS}$ , $T_J \leq 150^\circ\text{C}$ , $R_G = 2 \Omega$	5	V/ns
$P_D$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	300	W
$T_J$		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
$T_{JM}$		150	$^\circ\text{C}$
$T_{stg}$		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
$T_L$	1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s	300	$^\circ\text{C}$
$M_d$	Mounting torque	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight		TO-204 = 18 g, TO-247 = 6 g	

### TO-247 AD (IXFH)



### TO-204 AA (IXFM)



G = Gate, D = Drain,  
S = Source, TAB = Drain

### Features

- International standard packages
- Low  $R_{DS(on)}$  HDMOS™ process
- Rugged polysilicon gate cell structure
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Low package inductance  
- easy to drive and to protect
- Fast intrinsic Rectifier

### Applications

- DC-DC converters
- Synchronous rectification
- Battery chargers
- Switched-mode and resonant-mode power supplies
- DC choppers
- AC motor control
- Temperature and lighting controls
- Low voltage relays

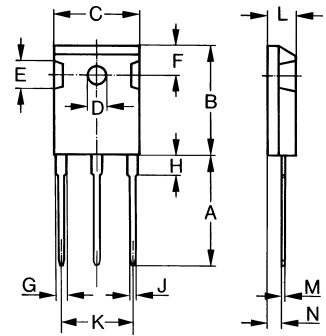
### Advantages

- Easy to mount with 1 screw (TO-247) (isolated mounting screw hole)
- Space savings
- High power density

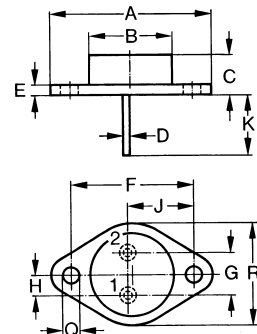
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
$V_{DSS}$	$V_{GS} = 0 \text{ V}$ , $I_D = 3 \text{ mA}$	800		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$ , $I_D = 4 \text{ mA}$	2.0		V
$I_{GSS}$	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}_{DC}$ , $V_{DS} = 0$			$\pm 100 \text{ nA}$
$I_{DSS}$	$V_{DS} = 0.8 \cdot V_{DSS}$ , $T_J = 25^\circ\text{C}$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$ , $T_J = 125^\circ\text{C}$			250 $\mu\text{A}$
				1 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}$ , $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$ , duty cycle $d \leq 2\%$	11N80		0.95 $\Omega$
		13N80		0.80 $\Omega$

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)			
		min.	typ.	max.	
$g_{fs}$	$V_{DS} = 10\text{ V}; I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ , pulse test	8	14	S	
$C_{iss}$	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$		4200	pF	
$C_{oss}$			360	pF	
$C_{rss}$			100	pF	
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 2\ \Omega$ (External)		20	50	ns
$t_r$			33	50	ns
$t_{d(off)}$			63	100	ns
$t_f$			32	50	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$		128	155	nC
$Q_{gs}$			30	45	nC
$Q_{gd}$			55	80	nC
$R_{thJC}$			0.42	K/W	
$R_{thCK}$		0.25		K/W	

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)			
		min.	typ.	max.	
$I_S$	$V_{GS} = 0\text{ V}$	11N80 13N80		11 13	A A
$I_{SM}$	Repetitive; pulse width limited by $T_{JM}$	11N80 13N80		44 52	A A
$V_{SD}$	$I_F = I_S, V_{GS} = 0\text{ V}$ , Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$ , duty cycle $d \leq 2\%$			1.5	V
$t_{rr}$	$I_F = I_S$ $-di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$ , $V_R = 100\text{ V}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$		250	ns
				400	ns
$Q_{RM}$			1	$\mu\text{C}$	
$I_{RM}$			8.5	A	

**TO-247 AD (IXFH) Outline**


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	19.81	20.32	0.780	0.800
B	20.80	21.46	0.819	0.845
C	15.75	16.26	0.610	0.640
D	3.55	3.65	0.140	0.144
E	4.32	5.49	0.170	0.216
F	5.4	6.2	0.212	0.244
G	1.65	2.13	0.065	0.084
H	-	4.5	-	0.177
J	1.0	1.4	0.040	0.055
K	10.8	11.0	0.426	0.433
L	4.7	5.3	0.185	0.209
M	0.4	0.8	0.016	0.031
N	1.5	2.49	0.087	0.102

**TO-204 AA (IXFM) Outline**


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	38.61	39.12	1.520	1.540
B	19.43	19.94	-	0.785
C	6.40	9.14	0.252	0.360
D	0.97	1.09	0.038	0.043
E	1.53	2.92	0.060	0.115
F	30.15	BSC	1.187	BSC
G	10.67	11.17	0.420	0.440
H	5.21	5.71	0.205	0.225
J	16.64	17.14	0.655	0.675
K	11.18	12.19	0.440	0.480
Q	3.84	4.19	0.151	0.165
R	25.16	25.90	0.991	1.020

Fig. 1 Output Characteristics

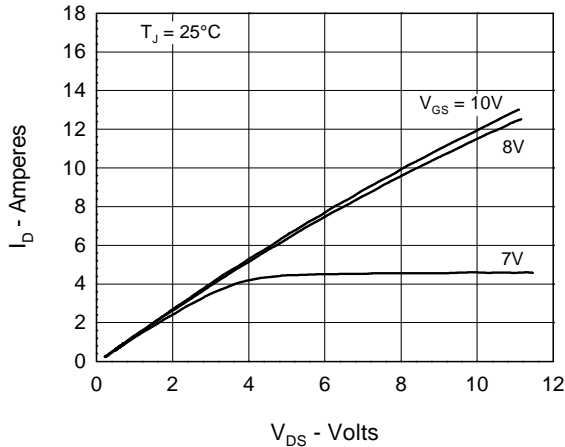


Fig. 2 Input Admittance

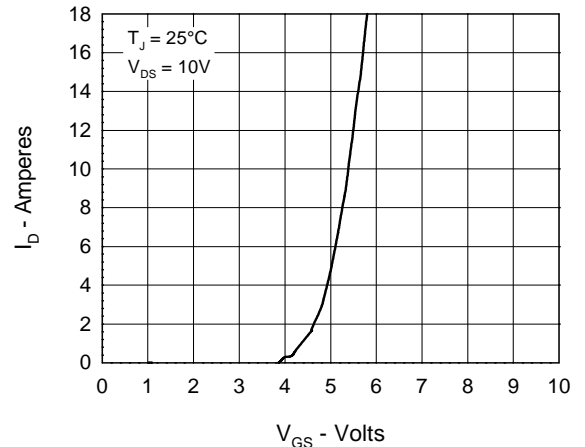


Fig. 3  $R_{DS(on)}$  vs. Drain Current

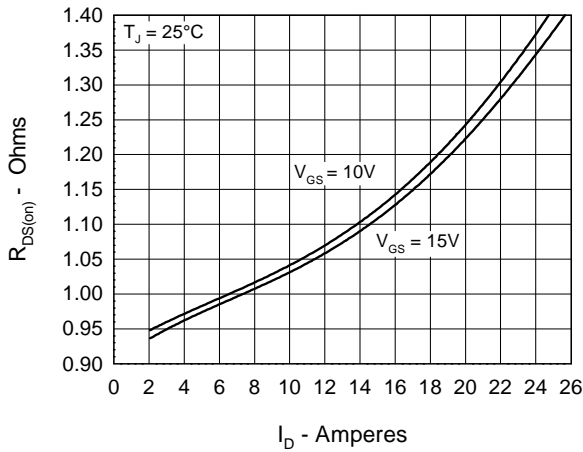


Fig. 4 Temperature Dependence of Drain to Source Resistance

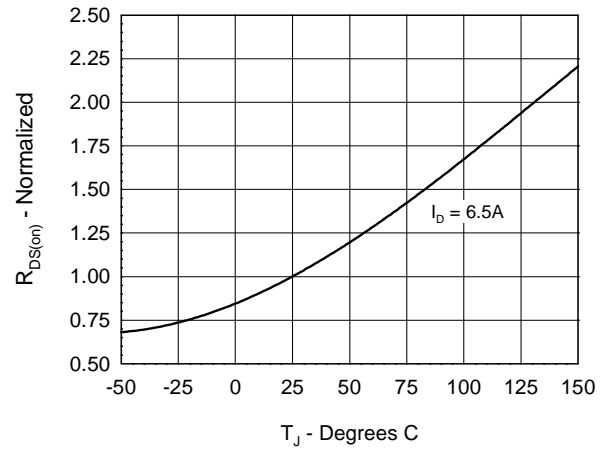


Fig. 5 Drain Current vs. Case Temperature

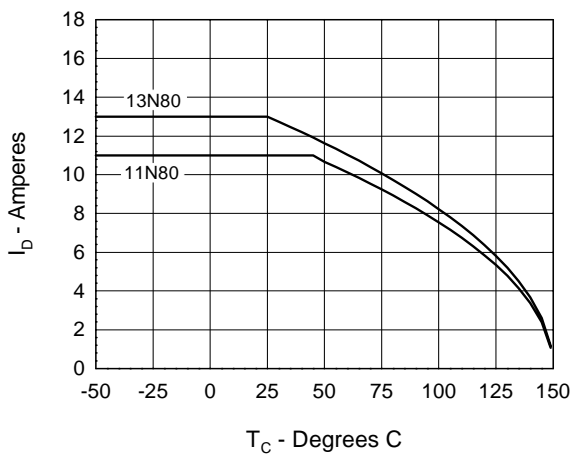


Fig. 6 Temperature Dependence of Breakdown and Threshold Voltage

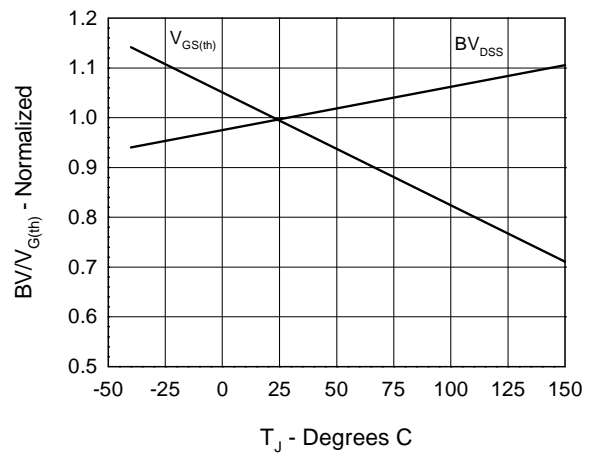


Fig.7 Gate Charge Characteristic Curve

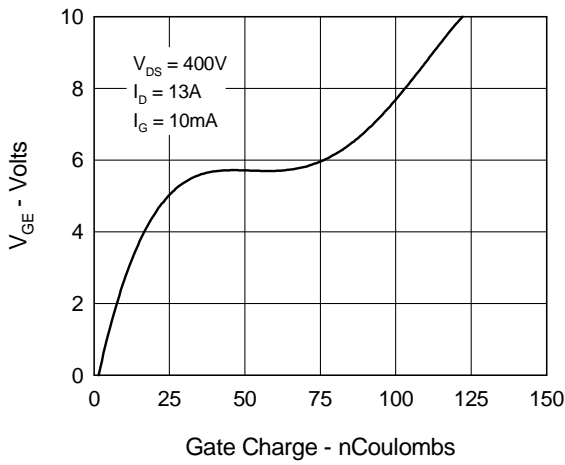


Fig.8 Forward Bias Safe Operating Area

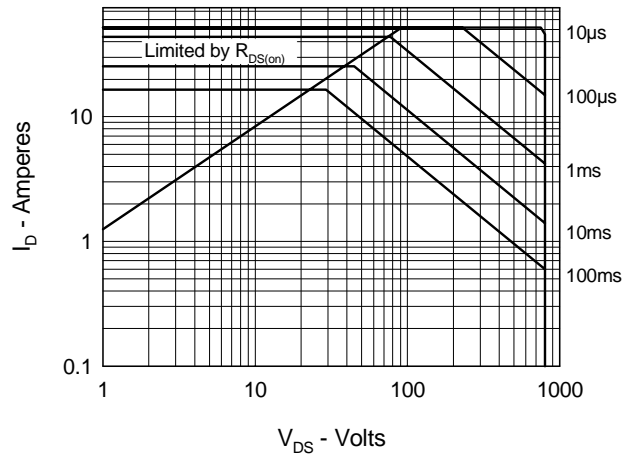


Fig.9 Capacitance Curves

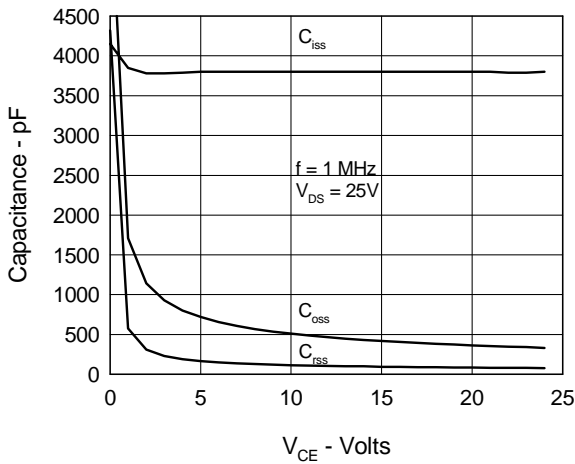


Fig.10 Source Current vs. Source to Drain Voltage

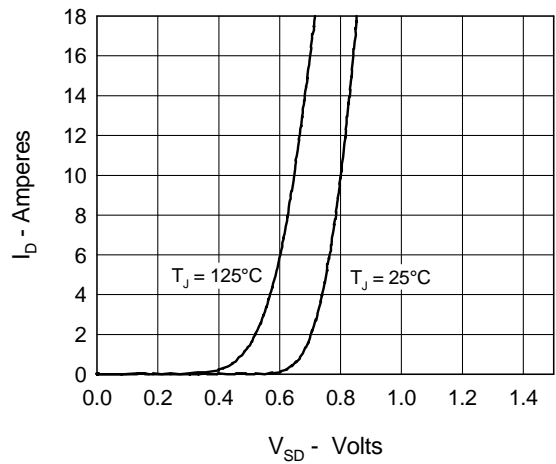
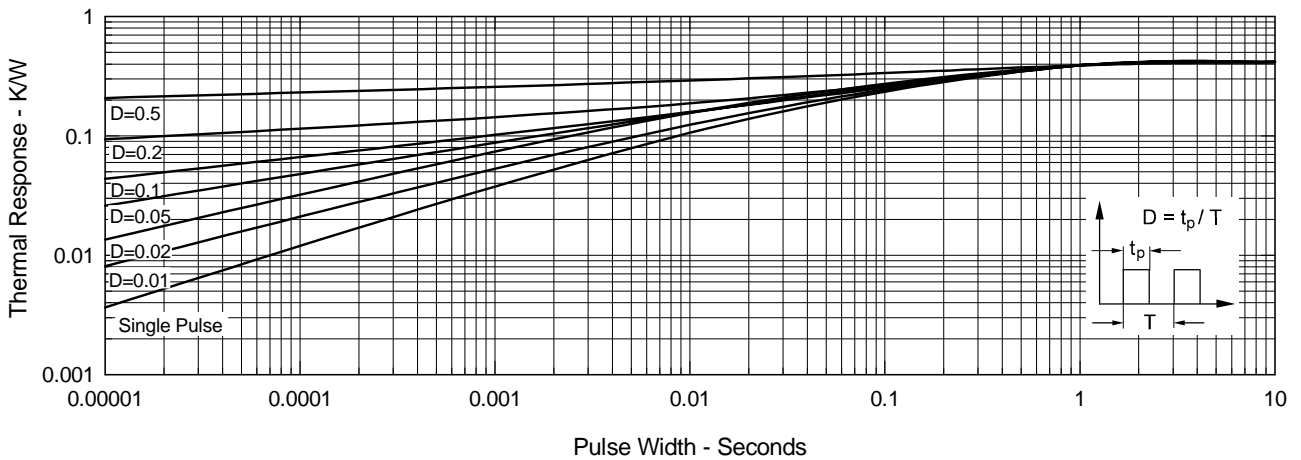


Fig.11 Transient Thermal Impedance





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.